

文部科学省

「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発事業」ワークショップ
(協力：一般社団法人GaNコンソーシアム、名古屋パワエレ塾)

GaNパワーデバイス および その応用への展望

2019.11.22 (金) 14:00~17:20

名古屋大学 ES総合館 1F ES会議室

＝講演内容＝

- パワエレ機器の現状と展望
(伊東 淳一 / 長岡技術科学大学)
- GaNパワーデバイスの現状と展望
(須田 淳、上杉 勉、加地 徹 / 名古屋大学)
- ボトルネックの高周波大電力磁性材料と開発課題
(藤崎 敬介 / 豊田工業大学)
- パネルディスカッション
(司会 山本真義 / 名古屋大学)

申込〆切
11/19 (火)
※延長しました

タイムスケジュールと申込み方法は、
次ページをご覧ください。

文部科学省「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」事業では、省エネルギー社会の実現に向けて、基礎基盤研究の課題が多い窒化ガリウム(GaN)等の次世代半導体に関し、我が国の強みを活かして実用化に向けた研究開発を加速することを目的としています。そのため、2030年に高周波・高出力で小型、軽量のパワーデバイス、パワーデバイスと制御回路等を融合した革新的なスマートパワーデバイスが実現することを念頭におきながら、GaN等の次世代半導体に関して、材料創製からデバイス化・システム応用までの研究開発を一体的に行う研究開発拠点を構築し、理論・シミュレーションも活用した基礎基盤研究を実施しています。

講演プログラム

14:00~14:15	オープニングトーク	山本 真義／名古屋大学
14:15~15:00	【講演】パワエレ機器の現状と展望	伊東 淳一／長岡技術科学大学
15:00~15:45	【講演】GaNパワーデバイスの現状と展望	須田 淳、上杉 勉、加地 徹 ／名古屋大学
休憩（15分）		
16:00~16:45	【講演】受動素子の現状と展望 ボトルネックの高周波大電力磁性材料と 開発課題	藤崎 敬介／豊田工業大学
16:45~17:20	《パネルディスカッション》 GaNパワーデバイス実用化への壁は？	講演者 および 山本 真義／名古屋大学（司会）

ご案内

- ◇参加対象者 パワーエレクトロニクス技術にご興味がある方
GaNコンソーシアム会員である機関に所属する方
名古屋パワエレ塾会員
- ◇定員 50名
- ◇募集期間 2019年11月19日（火）まで **※延長しました**
※応募者が定員に達した段階で募集を締め切ります。
- ◇参加費用 無料

★研究会終了後に懇親会を開催します。ぜひ、こちらもご参加ください。
参加費；3000円 会場；シェ・ジロー（講演会場の隣）

申込方法

下記事務局に、電子メールでご連絡ください。

申し込みの際は、

- ①参加者氏名 ②所属機関 ③職業(学生または役職) ④電話番号とメールアドレス
- ⑤懇親会への出欠

—の5点を明記してください。

場所・時間等の詳細は、参加登録後にメールでご連絡します。

※個人情報をご研究会の参加登録以外の目的で使用すること、及び第三者に提供することはありません。

【申込み・問い合わせ先】

文科省事業ワークショップ事務局

E-MAIL : power1122@imass.nagoya-u.ac.jp

【事務局メンバー】

名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 山本研究室
学術研究・産学官連携推進本部 企画・プロジェクト推進グループ：水野紘一、藤本裕雅、山口 淳